

(19) (KR)
(12) (A)

(51) . Int. Cl. 7 (11) 2002 - 0057022
G02F 1/1345 (43) 2002 07 11

(21) 10 - 2000 - 0087254
(22) 2000 12 30

(71) 136 - 1

(72) LCD - SBUTFT

(74)

(54)

5 -

가

가

TFT

TFT 가

4

(36)

(34)

10 μ m

TFT (30)

(40)

(38)

/ TFT

(30)

/ (40)

(36)

(40)

(hole)

(32)

(32)

TFT

가

ITO

6 -

가

(57)

1.

가

TFT

TFT 가

2.

1

3.

1

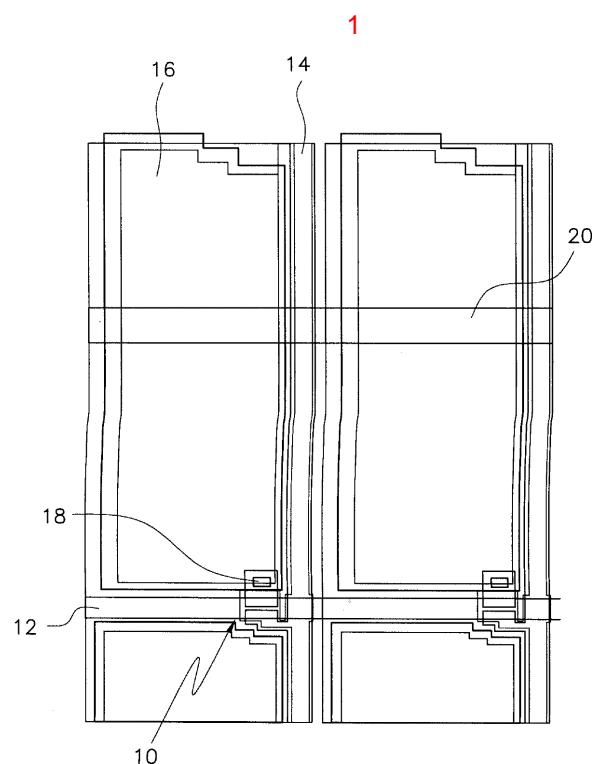
4.

1 ,

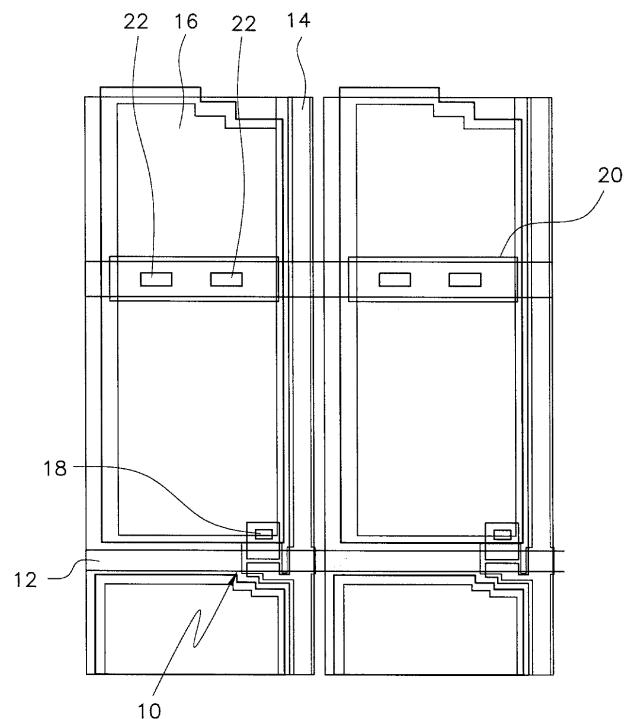
10 μ m

5.

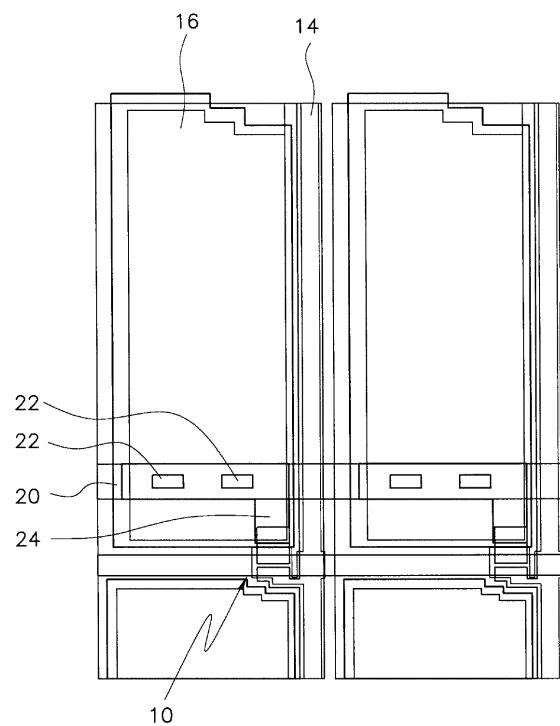
1 ,

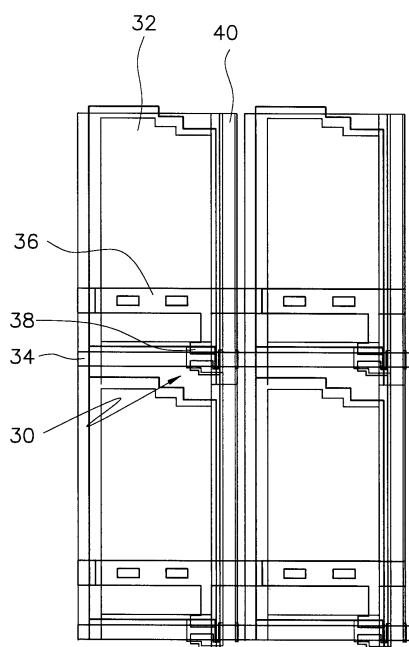


2



3





专利名称(译)	液晶显示器的辅助容量扩展像素结构		
公开(公告)号	KR1020020057022A	公开(公告)日	2002-07-11
申请号	KR1020000087254	申请日	2000-12-30
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	LEE JEONGHA		
发明人	LEE,JEONGHA		
IPC分类号	G02F1/1345		
CPC分类号	G02F1/136213 G02F1/136286 G02F1/1368		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种使用用于存储电容器的顶部电极和数据金属相同的金属，以允许存储电容器的扩展，同时使用5张掩膜工艺中的液晶显示装置的辅助电容扩展像素结构。根据液晶显示装置的辅助电容扩展像素结构根据本发明，所述阵列基板和具有到其在液晶显示装置中形成的过滤器上的彩色滤光片基板的颜色，形成在阵列基板的栅极信号布线和TFT的栅极信号数据线是垂直于布线与TFT装置所形成的信号以在栅极线和数据线的交叉点处的像素电极的位置，远离栅极布线和存储电容电极形成，其中，所述源极电极形成辅助电极以用作辅助电容的上电极，并且在辅助电容电极上形成与像素电极的连接部分。 4

